

Изобретение относится к области электроники и предназначено для изготовления запоминающих и коммутационных устройств, использующихся в вычислительной и коммутационной технике.

Устройство содержит основание из Pb, на которое последовательно нанесены слой, поглощающий поверхностные акустические волны, вентильный слой из сверхпроводящей керамики  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ , и управляющий слой из пьезокристалла GaAs, в центре которого нанесен встречноштыревой преобразователь из Cr-Al, причем между вентильным и управляющим слоями нанесены контакты из Cr-Cu. Контакты из Cr-Cu расположены по периметру окружности и состоят из продольных контактов, расположенных вдоль кристаллографической оси  $c$  состава  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ , которые совпадают с направлением распространения поверхностных акустических волн; поперечных контактов, расположенных перпендикулярно кристаллографической оси  $c$  состава  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ , которые перпендикулярны направлению распространения поверхностных акустических волн; промежуточных контактов, расположенных по периметру окружности между продольными и поперечными контактами.